【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年9月22日(2011.9.22)

【公開番号】特開2011-146701(P2011-146701A)
【公開日】平成23年7月28日(2011.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-030
【出願番号】特願2010-281528(P2010-281528)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/76　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/316　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　29/78　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/04　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/336　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/06　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/8234　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/12　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/088　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/76　Ｌ
Ｈ０１Ｌ　21/316　Ｓ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５２Ｒ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５３Ａ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５７Ｄ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５８Ｆ
Ｈ０１Ｌ　27/06　１０２Ａ
Ｈ０１Ｌ　27/12　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ｅ
Ｈ０１Ｌ　27/08　３３１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月5日(2011.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
前記塩素濃度が、前記第１の半導体－酸化物界面と前記第２の半導体－酸化物界面との間に、前記第１の極大点および前記第２の極大点未満の最小を有し、最小の塩素濃度が10^{15}ｃｍ$^{-3}$～10^{18}ｃｍ$^{-3}$である、請求項１または２に記載の半導体部品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
前記酸化物層が、前記第１および第２の半導体－酸化物界面間の酸化物層の寸法である

厚さを有し、当該厚さが１０ｎｍ～１μｍである、請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体部品。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
前記第１および第２の半導体領域がシリコン領域である、請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体部品。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
前記第１および第２の半導体領域が単結晶半導体領域である、請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体部品。